

关键指标

射频&本振频率: 0.6~1.4GHz
中频频率: DC~0.8GHz
本振功率: 13dBm
变频损耗: 10dB
LO/RF 隔离度: 35dB
芯片尺寸: 1.86mm×1.27mm×0.1mm

产品简介

HG121H-1 是一款无源双平衡混频器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 射频和本振频率为 0.6~1.4GHz, 中频频率为 DC~0.8GHz, 变频损耗为 10dB。

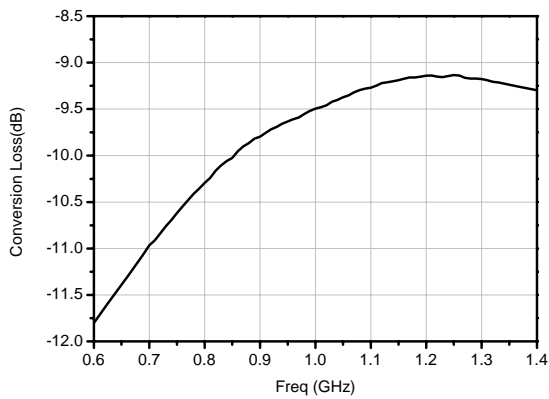
电性能 (T_A=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值
RF&LO 频率(GHz)	0.6~1.4		
IF 频率(GHz)	DC~0.8		
变频损耗(dB)	—	10	—
LO~RF 隔离度(dB)	—	35	—
LO~IF 隔离度(dB)	—	35	—
RF~IF 隔离度(dB)	—	15	—

典型测试曲线

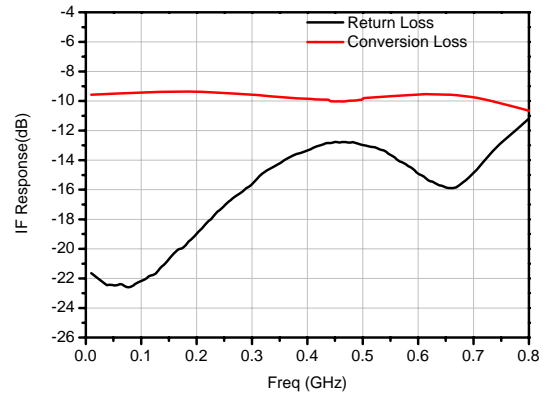
未注明情况下 IF=100MHz

变频损耗

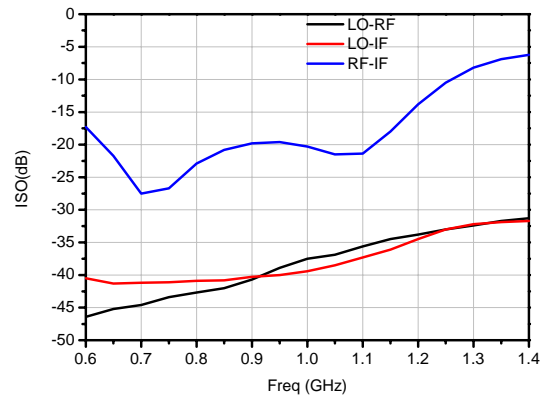


中频带宽

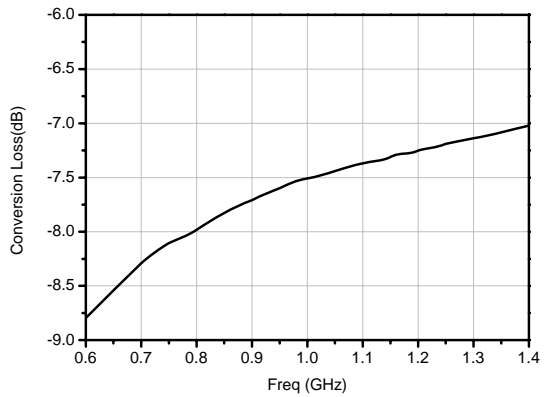
IF : 0.01-0.81GHz
RF: 1.41GHz
LO: 0.6GHz-1.4GHz



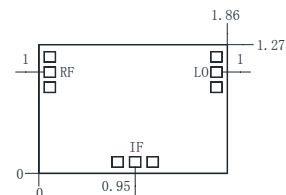
隔离度



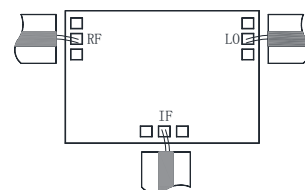
上变频损耗



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。